



日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

井2

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。
This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application:

1995年 8月 2日

出願番号
Application Number:

平成 7年特許願第216608号

出願人
Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所

1996年 6月 19日

特許庁長官
Commissioner
Patent Office

清川信二

出証番号 出証特平08-3028919

【書類名】 特許願
 【整理番号】 P003053-01
 【提出日】 平成 7年 8月 2日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【国際特許分類】 H01L 21/00
 【発明の名称】 半導体装置の作製方法
 【請求項の数】 11
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー
 ギー研究所内
 【氏名】 大谷 久
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー
 ギー研究所内
 【氏名】 宮永 昭治
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー
 ギー研究所内
 【氏名】 寺本 聰
 【発明者】
 【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半導体エネルギー
 ギー研究所内
 【氏名】 山崎 舜平
 【特許出願人】
 【識別番号】 000153878
 【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所
 【代表者】 山崎 舜平
 【手数料の表示】
 【納付方法】 予納

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置の作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

絶縁表面を有する基板上に非晶質珪素膜を成膜する工程と、
前記非晶質珪素膜を所定のパターンにパターニングする工程と、
前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させ
る工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させ結晶性珪素膜に変成する工程と

前記結晶性珪素膜のパターンの周囲をエッチングする工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する
工程と、
前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させ
る工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させる工程と、
前記所定の領域をエッチングする工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 3】

非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する
工程と、
前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させ
る工程と、
加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させると同時に前記所定の領域に前
記金属元素を偏析させる工程と、
前記所定の領域をエッチングする工程と、
を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項4】

非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する

工程と、

前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させ

る工程と、

加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させると同時に前記所定の領域に前記金属元素を偏析させ半導体装置の活性層となるべき領域またはチャネル形成領域となるべき領域から前記金属元素を除去する工程と、

前記所定の領域をエッティングする工程と、

を有することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4において、

珪素の結晶化を助長する金属元素として、

Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt、Cu、Auから選ばれた一種または複数種類のものを用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項6】

請求項1乃至請求項4において、加熱処理は450℃～700℃の温度で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項7】

請求項1乃至請求項4において、

非晶質珪素膜は石英基板上に成膜されており、

加熱処理は800℃～1100℃の温度で行われることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項8】

請求項2乃至請求項4において、

金属元素の拡散距離をDとして、

得られる結晶性珪素膜の中心部から所定の領域までの距離dが $d = D / 30$ ～Dで示されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 9】

請求項 8 において、 $d = 0.2 \mu m \sim 2 \mu m$ とすることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 10】

請求項 8 において、 $D = D_0 t \exp(\Delta E/kt)$ で示されることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項 11】

請求項 2 乃至請求項 4 において、所定の領域にリンイオンまたは酸素イオンを注入することにより、欠陥及び/または応力が集中した領域を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本明細書で開示する発明は、結晶性を有する珪素薄膜の作製方法を示す。またこの結晶性を有する珪素薄膜を用いた半導体装置の作製方法を示す。

【0002】

【従来の技術】

従来より、ガラス基板や石英基板上に形成された非晶質珪素膜を結晶化させて結晶性珪素膜を形成し、この結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタを構成する技術が知られている。

【0003】

この結晶性珪素膜を得る方法としては、プラズマ CVD 法等で成膜された非晶質珪素膜にレーザー光を照射し、結晶性珪素膜に変成する方法と、プラズマ CVD 法等で成膜された非晶質珪素膜に加熱処理を加え、結晶性珪素膜に変成する方法とに大別することができる。

【0004】

このような結晶性珪素膜を得る方法としては、特開平 06-232059 号公報に記載された技術が公知である。この技術は、珪素の結晶化を助長する金属元素を利用することにより、非晶質珪素膜をより低温で結晶化せるものである。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

本出願人らの研究によれば、上記珪素の結晶化を助長する金属元素を用いて結晶性珪素膜を得、さらにこの結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタを作製した場合、その特性にバラツキが生じやすい傾向が確認されている。

【0006】

本明細書で開示する発明は、珪素の結晶化を助長する金属元素を用いることによって結晶性珪素膜を得る技術において、局所的に金属元素が集中して存在してしまうことがないような技術を提供することを課題とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記の金属元素が結晶性珪素膜中において集中して存在してしまうという問題について鋭意研究を重ねた結果、以下に示す事項が確認されるに至った。

【0008】

図2に示すのは、ニッケル元素を用いることによって結晶化された結晶性珪素膜の1μm角におけるニッケル元素の固まりを観察した結果である。

【0009】

図2に示すデータを得た結晶性珪素膜の作製方法について以下に説明する。まずガラス基板上に500Å厚の非晶質珪素膜をプラズマCVD法で成膜する。そしてその表面にニッケル酢酸塩溶液を塗布する。この状態で非晶質珪素膜の表面にニッケル元素が接して保持された状態が実現される。そして図2中に記載されている加熱温度（図にはSPC温度と記載）で4時間の加熱処理を加える。こうしてガラス基板上の結晶性珪素膜を得る。

【0010】

図2に示す3種類のデータを得た試料の違いは、結晶性珪素膜を得るための加熱の温度である。

【0011】

図2に示すニッケル元素の固まりの観察方法は、得られた結晶性珪素膜をFPM（過水とフッ酸の混合溶液）でエッティングすることによって、ニッケルの固め

っている領域（この領域はニッケルシリサイド化している）を除去し、この除去された孔の数を電子顕微鏡によって数えることによって行った。

【0012】

このニッケルが固まっている領域を示す孔の状況を図3に示す。図3に示すのは、結晶性珪素膜の表面をFPMによってエッティングした後の状況を電子顕微鏡によって写した写真である。

【0013】

この観察方法は、ニッケル元素の固まりの数の絶対値を計測できるものではないが、その相対的な数の評価を行うことができる。

【0014】

図2に示すように、加熱処理の温度を高くする程、検出されるニッケルの固まりの数は少なくなる。しかし、SIMS（2次イオン分析方法）で計測したところ、ニッケル元素の濃度は加熱処理時（SPC時）の温度の違いによらずほとんどの同じであることが確認されている。このことから、ニッケル元素の偏析は、加熱処理時の温度が高くなる程、一つ一つの固まりが大きなものであることが予想される。

【0015】

また、加熱処理の温度が高くなる程、ニッケル元素の拡散距離は大きくなることが判明している。この拡散距離Dは、概略 $D_0 t \exp(-\Delta E/kT)$ によって表される。ここで D_0 は適当な定数、 t は加熱時間、 ΔE は適当な定数、 k はボルツマン定数、 T は加熱温度（SPC温度）である。この式で示される傾向は、ニッケル元素だけではなく、他の金属元素についてもいえることである。

【0016】

上式から明らかなように、加熱温度を高くすると指数関数的にニッケル元素の拡散距離は大きくなる。一方、加熱温度が高くなる程ニッケル元素の固まりは大きくなる。

【0017】

また本出願人らの研究によれば、応力歪が集中している領域には、ニッケル元素が集中しやすいことが判明している。

【0018】

以上述べた知見に基づいて本明細書に開示する発明はなされたものである。

本明細書で開示する発明の一つは、

絶縁表面を有する基板上に非晶質珪素膜を成膜する工程と、

前記非晶質珪素膜を所定のパターンにパターニングする工程と、

前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、

加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させ結晶性珪素膜に変成する工程と

前記結晶性珪素膜のパターンの周囲をエッチングする工程と、

を有することを特徴とする。

【0019】

また他の発明の構成は、

非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する工程と、

前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、

加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させる工程と、

前記所定の領域をエッチングする工程と、

を有することを特徴とする。

【0020】

また他の発明の構成は、

非晶質珪素膜の所定の領域に欠陥及び／または応力が集中した領域を形成する工程と、

前記非晶質珪素膜に接して珪素の結晶化を助長する金属元素を接して保持させる工程と、

加熱処理を加え前記非晶質珪素膜を結晶化させると同時に前記所定の領域に前記金属元素を偏析させる工程と、

前記所定の領域をエッチングする工程と、

を有することを特徴とする。

【0021】

上記書く発明において、一般にガラス基板が用いられる場合は、加熱処理の温度を450°C~700°Cの温度とすることが好ましい。

【0022】

また基板として石英基板を用いた場合には、加熱処理温度を800°C~1100°Cとすることが好ましい。特にこのように高い温度とすることは高い結晶性を得る上で非常に好ましい。

【0023】

本明細書で開示する発明において利用できる珪素の結晶化を助長する金属元素としては、Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pd、Os、Ir、Pt、Cu、Auから選ばれた一種または複数種類のものを用いることができる。

【0024】

この金属元素の導入方法としては、金属元素を含んだ溶液を用いることが好ましい。この溶液を用いる方法は、当該金属元素を膜状に設けることができるので、非晶質珪素膜に表面に均一に接して保持させることができると有用性がある。

【0025】

また、当該金属元素の濃度を調整することが容易であるという顕著な特徴を有する。珪素の結晶化を助長する金属元素は、珪素膜中におけるその濃度を極力小さくすることが望まれる。従って、導入される金属元素の量を調整することは非常に重要な技術となる。

【0026】

このような溶液を用いた方法について以下に示す。まず珪素の結晶化を助長する金属元素としてNiを利用する場合には、ニッケル化合物である臭化ニッケル、酢酸ニッケル、蔴酸ニッケル、炭酸ニッケル、塩化ニッケル、沃化ニッケル、硝酸ニッケル、硫酸ニッケル、蟻酸ニッケル、ニッケルアセチルアセトネート、4-シクロヘキシル酪酸ニッケル、酸化ニッケル、水酸化ニッケル、2-エチルヘキサン酸ニッケルから選ばれた少なくとも1種類の溶液を用いることができる。

きる。

【0027】

また、Niを無極性溶媒である、ベンゼン、トルエン、キシレン、四塩化炭素、クロロホルム、エーテル、トリクロロエチレン、フロンから選ばれた少なくとも一つに含有させたものを用いることができる。

【0028】

珪素の結晶化を助長する金属元素としてFe(鉄)を用いる場合には、鉄塩として知られている材料、例えば臭化第1鉄($FeBr_2 \cdot 6H_2O$)、臭化第2鉄($FeBr_3 \cdot 6H_2O$)、酢酸第2鉄($Fe(C_2H_3O_2)_3 \cdot xH_2O$)、塩化第1鉄($FeCl_2 \cdot 4H_2O$)、塩化第2鉄($FeCl_3 \cdot 6H_2O$)、フッ化第2鉄($FeF_3 \cdot 3H_2O$)、硝酸第2鉄($Fe(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$)、リン酸第1鉄($Fe_3(Po_4)_2 \cdot 8H_2O$)、リン酸第2鉄($FePO_4 \cdot 2H_2O$)から選ばれたものを用いることができる。

【0029】

また珪素の結晶化を助長する金属元素としてCo(コバルト)を用いる場合には、その化合物としてコバルト塩として知られている材料、例えば臭化コバルト($CoBr \cdot 6H_2O$)、酢酸コバルト($Co(C_2H_3O_2)_2 \cdot 4H_2O$)、塩化コバルト($CoCl_2 \cdot 6H_2O$)、フッ化コバルト($CoF_2 \cdot xH_2O$)、硝酸コバルト($Co(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$)から選ばれたものを用いることができる。

【0030】

また珪素の結晶化を助長する金属元素としてRu(ルテニウム)を用いる場合、その化合物としてルテニウム塩として知られている材料、例えば塩化ルテニウム($RuCl_3 \cdot H_2O$)を用いることができる。

【0031】

また珪素の結晶化を助長する金属元素としてRh(ロジウム)を用いる場合、その化合物としてロジウム塩として知られている材料、例えば塩化ロジウム($RhCl_3 \cdot 3H_2O$)を用いることができる。

【0032】

また珪素の結晶化を助長する金属元素としてPd(パラジウム)を用いる場合

、その化合物としてパラジウム塩として知られている材料、例えば塩化パラジウム ($PdCl_2 \cdot 2H_2O$) を用いることができる。

【0033】

また珪素の結晶化を助長する金属元素として Os (オスニウム) を用いる場合、その化合物としてオスニウム塩として知られている材料、例えば塩化オスニウム ($OsCl_3$) を用いることができる。

【0034】

また珪素の結晶化を助長する金属元素として Ir (イリジウム) を用いる場合、また珪素の結晶化を助長する金属元素として Os (オスニウム) を用いる場合、その化合物としてイリジウム塩として知られている材料、例えば三塩化イリジウム ($IrCl_3 \cdot 3H_2O$) 、四塩化イリジウム ($IrCl_4$) から選ばれた材料を用いることができる。

【0035】

また珪素の結晶化を助長する金属元素として Pt (白金) を用いる場合、その化合物として白金塩として知られている材料、例えば塩化第二白金 ($PtCl_4 \cdot 5H_2O$) を用いることができる。

【0036】

また珪素の結晶化を助長する金属元素として Cu (銅) を用いる場合、その化合物として酢酸第二銅 ($Cu(CH_3COO)_2$) 、塩化第二銅 ($CuCl_2 \cdot 2H_2O$) 、硝酸第二銅 ($Cu(NO_3)_2 \cdot 3H_2O$) から選ばれた材料を用いることができる。

【0037】

また珪素の結晶化を助長する金属元素として金 (Au) を用いる場合、その化合物として三塩化金 ($AuCl_3 \cdot xH_2O$) 、塩化金塩 ($AuHCl_4 \cdot 4H_2O$) から選ばれた材料を用いることができる。

【0038】

【作用】

例えば図6に示すように、得ようとする結晶性珪素膜のパターン100の周辺部108を除去する。この108の領域には、パターン103を得た場合に形成される応力歪みや欠陥がその周辺部106に集中している。そして106の領域

には高い濃度で珪素の結晶化を助長する金属元素が存在する。従って、この領域を除去することで、当該金属元素の影響を排除した結晶性珪素膜100を得ることができる。

【0039】

また人為的に欠陥や応力が集中した領域を形成する場合に、当該金属元素の拡散距離Dを考慮する。具体的には、最終的に得られるパターンの中心部と欠陥や応力が集中した領域との距離dを $d = D / 30 \sim D$ とすることによって、効果的に金属元素を前記欠陥や応力が集中した領域に追いやることができる。特に薄膜トランジスタのチャネル形成領域から前記金属元素を除去することができ、安定した動作をする薄膜トランジスタを得ることができる。

【0040】

このように欠陥や応力が集中した領域を珪素の結晶化を助長する金属元素のゲッタリング領域とすることによって、結晶性珪素膜を用いた半導体装置の信頼性を高めることができる。

【0041】

【実施例】

【実施例1】

以下の実施例においては、珪素の結晶化を助長する金属元素として、ニッケルを用いる例を主に示す。これは、ニッケルを用いた場合に最もその効果を安定して得られるからである。また、ニッケル以外に好ましい元素としては、パラジウム、白金、銅を挙げることができる。これらの元素を用いた場合には、ニッケルを用いる場合と同様な効果を得ることができる。

【0042】

図1の本実施例の作製工程の概略を示す。まずガラス基板101上に下地膜として酸化珪素膜102を3000Åの厚さにプラズマCVD法またはスパッタ法で成膜する。この酸化珪素膜102は、ガラス基板101からの不純物の拡散を防止する機能を有する。またガラス基板101と後に形成される珪素薄膜との間に生じる応力を緩和させる機能を有する。

【0043】

次に酸化珪素膜上に図示しない非晶質珪素膜を500Åの厚さにプラズマCVD法でもって成膜する。次に最終的に得る薄膜トランジスタの活性層より大きめのパターンにパターンニングを行い、非晶質珪素膜でなる島状のパターン103を形成する。（図1（A））

【0044】

本実施例で用いた500Å厚のプラズマCVD膜においては、550°C、4時間の条件におけるニッケル元素の最大の拡散距離はおよそ2μmであることが判明している。そこで図1を上面から見た状態を示す図6に示すdの距離を2μmとする。なお、aで示される距離は0.5μmとする。

【0045】

このパターンの形成は垂直異方性を有するプラズマエッティングによって行うことが好ましい。これはプラズマエッティングを行うと、島状に形成されるパターンの縁の領域にプラズマダメージにより応力歪みや欠陥が生じやすくなるからである。

【0046】

そして所定の濃度に調整されたニッケル酢酸溶液をスピンドル法で塗布し、ニッケル元素104がパターンングされた非晶質珪素膜103の露呈した表面に接して保持された状態とする。（図1（A））

【0047】

この状態で600°C、4時間の加熱処理を行う。この加熱処理は、ガラス基板の耐えられる温度の範囲内においてなるべく高い温度とすることが望ましい。従って、石英基板を用いた場合には、加熱の温度を800～1100°Cとして結晶化を行わすことが望ましい。

【0048】

この加熱処理を行うことにより、非晶質珪素膜のパターン103は結晶化される。またこの時、パターン103の周辺部にニッケル元素は拡散していき、その周辺部に集中することになる。このニッケル元素がパターン103の周辺部に集中する傾向は、加熱処理の温度が高くなる程顕著なのとなる。

【0049】

このニッケル元素の拡散に従って、非晶質珪素膜の結晶化が進行し、パターン 103 は結晶性珪素膜 105 に変成される。

【0050】

またこの時、プラズマダメージや応力歪みが集中しているパターンの縁の領域 106 には、ニッケル元素が集中することになる。（図1（B））

【0051】

次にレジストマスク 107 を用いて露呈した 108 の領域をエッチング除去する。即ち、ニッケル元素が集中している領域をエッチング除去する。このエッチング工程によって、薄膜トランジスタの活性層 100 が完成する。（図1（C））

【0052】

ここで、図6に示すように除去される 108 の領域は a で示される寸法を 20 μ m とする。本実施例においては、d で示される寸法を 20 μ m とし、図に示されるように 15 μ m \times 30 μ m の矩形パターン 100 を得る。このパターン 100 が薄膜トランジスタを構成する活性層となる。

【0053】

本実施例に示す構成においては、除去される 108 の領域にニッケルの集中している領域 106 が存在するので、結果として 100 で示される活性層中にはほとんどニッケル元素の固まりが存在しない状態とができる。

【0054】

さらにスカンジウムを 0.2 wt % を含有させたアルミニウム膜をスパッタ法または電子ビーム蒸着法で成膜する。ここでスカンジウムを含有させるのは、後の工程においてアルミニウムの異常成長によるヒロック（刺状あるいは針状の突起）の発生を抑制するためである。

【0055】

そしてこのアルミニウム膜をペーニングすることによって、ゲイト電極 111 を形成する。次に電解溶液中においてゲイト電極 111 を陽極とした陽極酸化を行うことにより、陽極酸化膜 112 を形成する。この陽極酸化膜 112 の膜厚は 500 \AA とする。この陽極酸化膜 112 は、ヒロックを発生を抑制するために非

常に効果がある。またこの陽極酸化膜 112 を厚く形成することにより、後の不純物イオンの注入工程において、オフセットゲイト領域を形成することができる。(図1 (D))

【0056】

図1 (D) の状態を得たら、P (リン) イオンの注入をプラズマドーピング法を用いて行う。この工程ではゲイト電極 108 がマスクとなることによって、自己整合的にソース領域 113 とチャネル形成領域 114 とドレイン領域 115 が形成される。(図1 (D))

【0057】

ここではPイオンを注入することによって、Nチャネル型の薄膜トランジスタを作製する例を示す。しかし、Bイオンの注入を行えば、Pチャネル型の薄膜トランジスタを作製することができる。

【0058】

次に層間絶縁膜として酸化珪素膜 116 を7000Åの厚いプラズマCVD法で成膜する。さらにコンタクトホールの形成を行い、チタン膜とアルミニウム膜とチタン膜との積層膜でもって、ソース電極 117 とドレイン電極 118 とを形成する。こうして図1 (E) に示す薄膜トランジスタを完成させる。

【0059】

本実施例の作製工程を採用した場合、活性層 100 にニッケル元素が集中して存在する領域が形成されることを抑制することができるので、ニッケル元素の存在による不都合を抑えることができる。

【0060】

【実施例2】

本実施例は、実施例1に示す工程に組み合わせて、さらにレーザー光の照射を行い、より高い結晶性を得る構成に関する。また本実施例では石英基板を用いる例を示す。

【0061】

図4に本実施例の作製工程を示す。まず図1に示す工程と同様にして、石英基板 401 上に下地膜として酸化珪素膜 102 を成膜する。ここでは、石英基板と

後に形成される珪素膜との間に働く応力の緩和を行うために酸化珪素膜102を5000Åの厚さに成膜する。

【0062】

次に非晶質珪素膜を減圧熱CVD法で1000Åの厚さに成膜する。次にパターニングを行うことによって、島状のパターン103を形成する。(図4(A))

【0063】

そしてニッケル酢酸塩溶液をスピンドルコート法によって塗布し、104で示されるようにニッケル元素が膜状に非晶質珪素膜でなる島状のパターン103の表面に接して保持された状態とする。(図4(A))

【0064】

そして850℃、4時間の加熱処理を行い、非晶質珪素膜でなる島状のパターン103を結晶性珪素膜に変成する。この工程においては、加熱の温度が高いので、実施例1の場合に比較して、ニッケル元素がパターンの周辺部により集中する。(図4(B))

【0065】

こうして結晶性珪素膜105とニッケル元素が集中して存在している領域106を得ることができる。そして、レジストマスク107を用いて、パターンの周辺部106をエッチング除去する。この工程でニッケル元素が集中的に存在している領域が選択的に除去される。(図4(C))

【0066】

そしてレジストマスク107を取り除くことによって、薄膜トランジスタの活性層を構成する島状のパターンを有した結晶性珪素膜402を得る。この402で示される領域は図4(B)の109で示される領域に相当する。

【0067】

次に図4(D)に示すようにレーザー光の照射を行う。このレーザー光の照射を行うことで、島状のパターンを有した結晶性珪素膜402の結晶性をさらに高くすることができる。

【0068】

また本実施例においては、レーザー光の照射を行った後にさらに800°C、2時間の加熱処理を行う。この加熱処理を行うことで、レーザー光の照射に際して生じた膜中の欠陥を減少させることができる。(図4 (E))

【0069】

なお、この再度の加熱処理を行わなくても十分に結晶性の高い結晶性珪素膜を得ることができる。従って、作製工程を簡略化させたい場合には、この加熱処理工程を省略してもよい。

【0070】

このように結晶性珪素膜でなる活性層402を得た後、図1に示した工程に示すような工程に従って、活性層402を用いた薄膜トランジスタを作製する。

【0071】

〔実施例3〕

本実施例は、図4に示す工程において、レーザー光の照射の代わりに加熱処理を行う構成に関する。図5に本実施例の作製工程を示す。まず石英基板401上に下地膜として酸化珪素膜102を5000Åの厚さにプラズマCVD法で成膜する。次に図示しない非晶質珪素膜を1000Åの厚さに減圧熱CVD法で成膜する。

【0072】

次にこの非晶質珪素膜をパターニングして図5 (A) に示すように島状のパターン103を形成する。さらにニッケル酢酸塩溶液をスピンドルコート法で塗布して104で示されるようにニッケル元素を膜状に設ける。(図5 (A))

【0073】

そして850°C、4時間の加熱処理を加えることにより、結晶性珪素膜109を得る。この状態においては、結晶性珪素膜109の周辺にニッケル元素が集中して存在している。(図5 (B))

【0074】

次にレジストマスク107を配置して図5 (C) に示すように108の領域をエッチング除去する。この際、多少の余裕をみて109の領域も少しエッチングする。

【0075】

こうして図5 (D) に示すように結晶性を有する珪素膜でなる島状のパターン110を得る。このパターン110は後に薄膜トランジスタの活性層となる。

【0076】

本実施例では図5に示す状態において、再度の加熱処理を行う。この加熱処理によって、島状のパターン110の結晶性をさらに高めることができる。なお、この加熱処理の後にさらにレーザー光や強光の照射を行ってもよい。

【0077】

【実施例4】

本実施例は、最終的に薄膜トランジスタの活性層701となる領域の周囲の非晶質珪素膜に開口を形成し、この開口が形成された領域に珪素の結晶化を助長する金属元素を偏析させることを特徴とする。

【0078】

本実施例を実施するには、まずプラズマCVD法や減圧熱CVD法でもって、適當な絶縁表面を有する基板上に非晶質珪素膜700を成膜する。次いで非晶質珪素膜の一部を702で示されるようにエッチング除去し、開口を形成する。この開口の計上は矩形状に限らず、円形形状やスリット状であってもよい。

【0079】

ここでは珪素の結晶化を助長する金属元素としてニッケルを用いる例を説明する。上記の開口を形成したら、所定の濃度に調整したニッケル酢酸塩溶液を塗布し、ニッケル元素が膜状に非晶質珪素膜700に接して保持された状態とする。

【0080】

そして、加熱処理を施すことにより、非晶質珪素膜700を結晶化させる。この時、702で示される開口部分にニッケル元素が集中することになる。これは、開口702の領域に欠陥や応力歪が集中して存在しているからである。

【0081】

本実施例に示すような構成は、金属元素の拡散距離を大きくでき、しかもパターンの寸法の小さい場合に有効である。例えば、石英基板を用いて、微細な集積回路を構成する場合に利用することが有効である。

【0082】

図7においてcに示す距離も

$$c = D/30 \sim D$$

$$D = D_0 \cdot t \exp(\Delta E/kT)$$

で示される条件を満足する必要がある。ただし一般にはDに示す金属元素の拡散距離を実測で求めることが簡便である。

【0083】

ここでDは最大の拡散距離であるが、最低の拡散距離はこの数十分の1程度となる。この最低の拡散距離よりも上記cで示される距離を小さくとると、ニッケル元素を完全に排除した構成とすることができます。具体的にはcの値を5μm以下にすると、ニッケル濃度を非常に小さくすることができる。上記Dの値は、出発膜の成膜条件や成膜方法、さらには加熱方法によって大きくなる。一般的にはDの値として1μm～5μmとなる。よってdの値としては、2μm以下、好ましくは1μm以下とすることが好ましい。

【0084】

〔実施例5〕

本実施例の作製工程の概略を図8に示す。図8に示す作製工程においては、基板として石英基板を用いる例を示す。まず石英基板801上に下地膜として酸化珪素膜802を5000Åの厚さにプラズマCVD法で成膜する。次に図示しない非晶質珪素膜を7000Åの厚さに成膜する。そしてパターニングを行うことにより、図8(A)の803に示すパターンを形成する。

【0085】

次に所定の濃度に調整したニッケル酢酸塩溶液を塗布し、ニッケル元素が803で示されるように膜状に設けられた状態とする。(図8(A))

【0086】

次に950℃、4時間の加熱処理を加えることにより、結晶性珪素膜804を得る。(図8(B))

【0087】

次に等方性のエッチング手段を利用して、805で示す島状の形状を有した結

晶性珪素膜の表面をエッティングする。この工程で厚さが 1500 Å の結晶性珪素膜 806 を得る。(図 8 (C))

【0088】

次に 950 °C の温度で熱酸化を行い、島状の結晶性珪素膜 806 の露呈した表面に厚さ 500 Å の熱酸化膜を形成する。こうして、薄膜トランジスタに利用できる結晶性珪素膜で構成される活性層 806 を得る。(図 8 (D))

【0089】

【実施例 6】

本実施例は、珪素の結晶化を助長する金属元素の除去効果をさらに高めた構成に関する。図 9 に本実施例の作製工程を示す。まずガラス基板 901 上に下地膜として酸化珪素膜 902 を 3000 Å の厚さに成膜する。

【0090】

次に非晶質珪素膜をプラズマ CVD 法で 500 Å の厚さに成膜する。さらにこれをパターニングすることにより、903 で示される島状の領域を形成する。そして所定の濃度に調整されたニッケル酢酸塩溶液をスピンドルコート法で塗布し、ニッケル元素を 904 で示されるように膜状に設ける。(図 9 (A))

【0091】

次にレジストマスク 905 を配置し、P (リン) イオンの注入を行う。この工程において、P イオンは 906 で示される領域に注入される。この P イオンの注入によって 906 で示される領域には欠陥が高い密度で形成される。また 907 で示される領域には P イオンは注入されない。(図 9 (B))

【0092】

次にレジストマスク 905 を取り除き、550 °C、4 時間の加熱処理を行う。この工程で非晶質珪素膜の全体は結晶化する。この時、903 で示されるパターンの縁周辺部に存在する 906 の領域にニッケル元素は集中する。この作用は、パターンの縁であること、906 の領域に金属元素のゲッタリング作用を有する P (リン) が注入されていること、さらに P イオンの注入によって、906 の領域に欠陥が高密度に形成されていること、によって生じる。

【0093】

次に図9 (C) に示すように新たなレジストマスク908を配置し、露呈した珪素の膜の領域をエッチングする。こうしてニッケル元素を除去した島状の結晶性珪素膜でなる領域909を得ることができる。なおここではリンイオンを用いたが、酸素イオンを用いてもよい。(図9 (D))

【0094】

【発明の効果】

予めパターニングされた非晶質珪素膜のパターンを珪素の結晶化を助長する金属元素を利用した加熱処理によって結晶化させ、さらに当該金属元素の集中しているパターンの周辺領域を除去することにより、当該金属元素の集中した部分の少ないまたはない結晶性珪素膜のパターンを得ることができる。

【0095】

即ち、珪素の結晶化を助長する金属元素を用いることによって結晶性珪素膜を得る技術において、局所的に金属元素が集中して存在してしまうことがないような技術を得ることができる。

【0096】

そして、本明細書で開示する発明を利用することにより、薄膜トランジスタの特性を向上させることができる。また得られる薄膜トランジスタの作製歩留りを高めることができる。また得られる薄膜トランジスタの特性を安定させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図2】 結晶性珪素膜中の単位面積中に含まれるニッケル元素の固まりの数を示すグラフ図。

【図3】 結晶性珪素膜を示す写真。

【図4】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図5】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図6】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図7】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図8】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【符号の説明】

101 ガラス基板
 102 下地膜（酸化珪素膜）
 103 島状にパターニングされた非晶質珪素膜のパターン
 104 膜状に設けられたニッケル元素
 105 島状の形状を有した結晶性珪素膜のパターン
 106 ニッケル元素が偏析した領域
 107 レジストマスク
 108 エッチング除去される領域
 100 結晶性珪素膜でなる活性層
 110 ゲイト絶縁膜（酸化珪素膜）
 111 ゲイト電極
 112 陽極酸化膜
 113 ソース領域
 114 チャネル形成領域
 115 ドレイン領域
 116 層間絶縁膜（酸化珪素膜）
 117 ソース電極
 118 ドレイン電極
 401 石英基板
 402 結晶性珪素膜でなる活性層
 700 非晶質珪素膜
 701 活性層となるべき領域
 702 非晶質珪素膜に形成された開口
 801 石英基板
 802 酸化珪素膜
 803 非晶質珪素膜
 804 膜状に設けられたニッケル元素
 805 結晶性珪素膜

806 エッチングされる領域

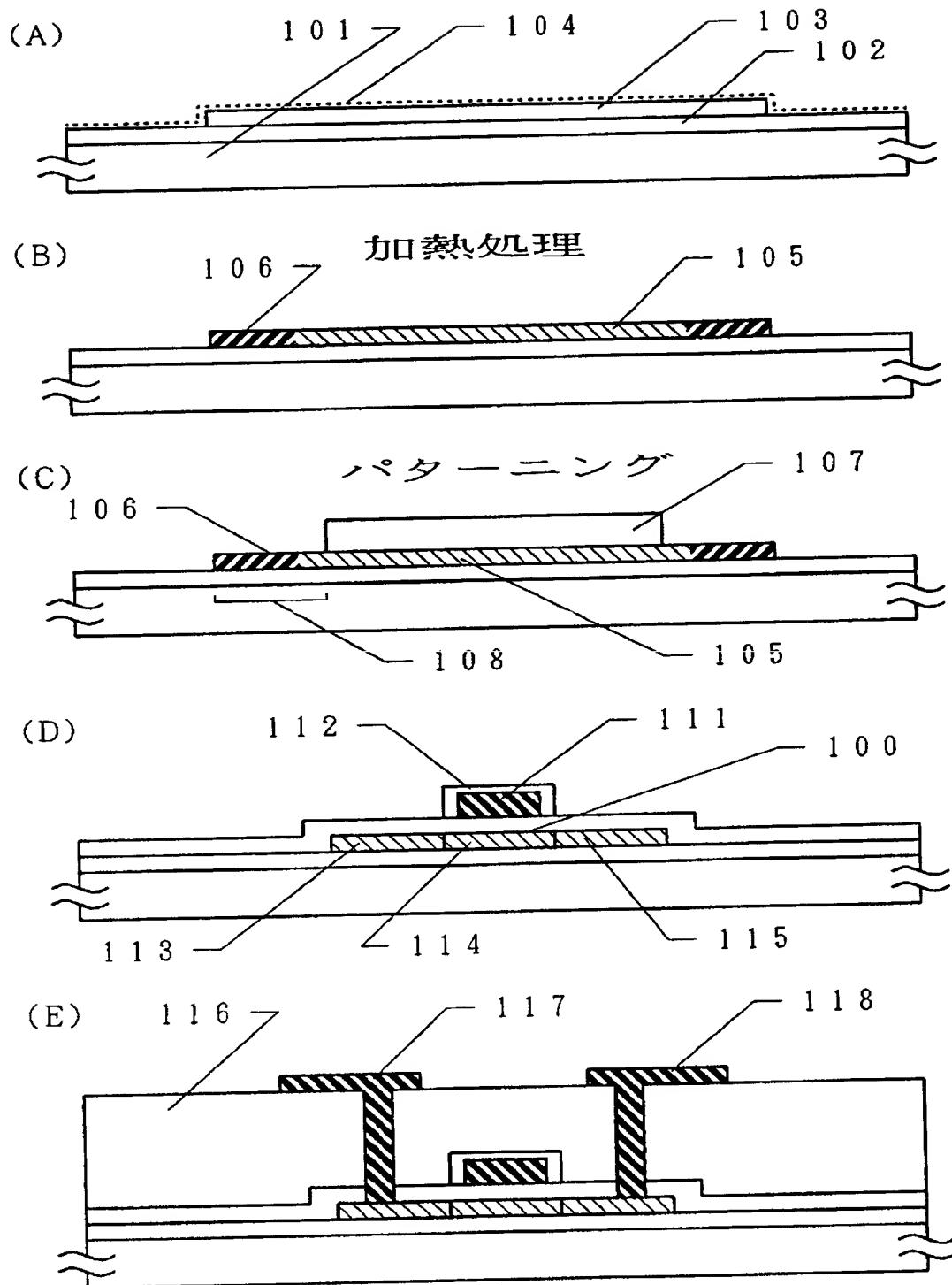
807 活性層

808 ゲイト絶縁膜

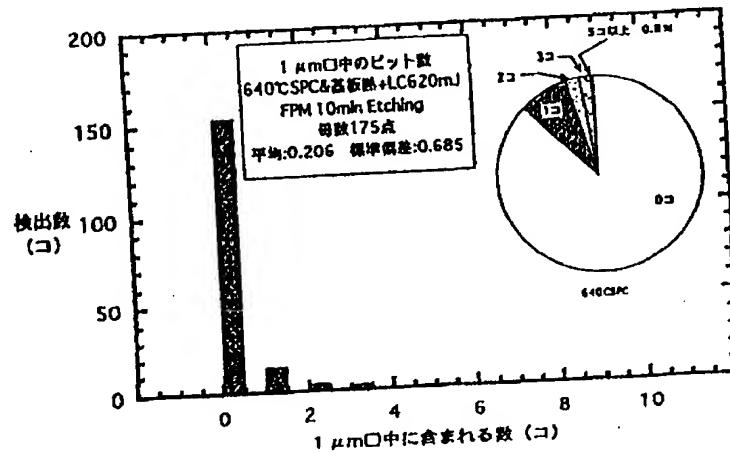
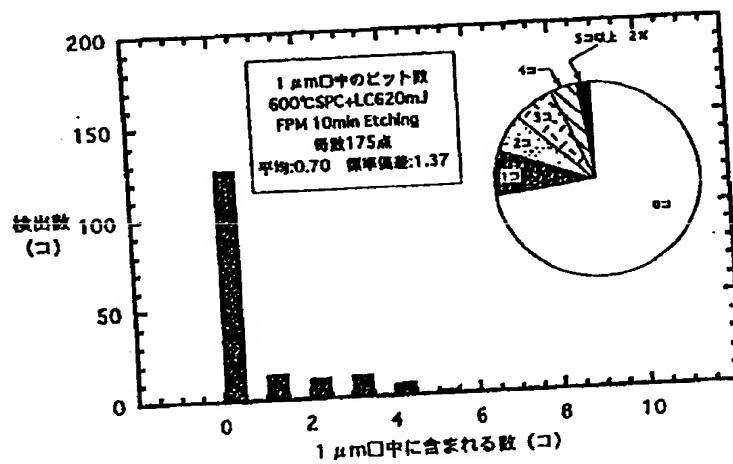
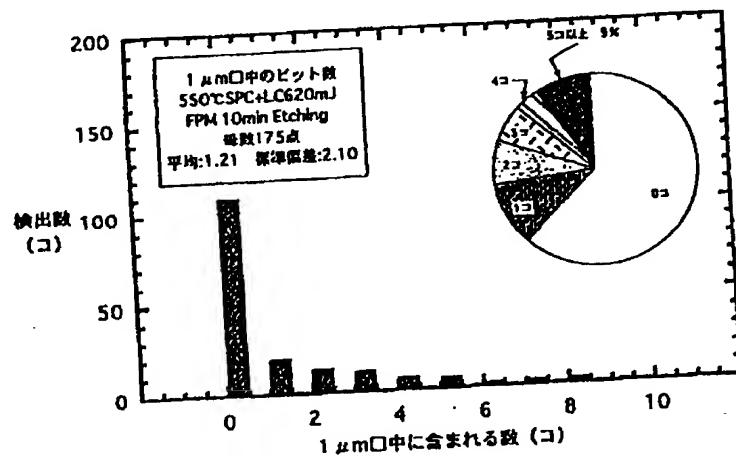
【書類名】

図面

【図1】

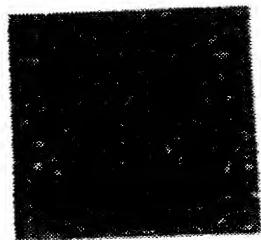


【図2】

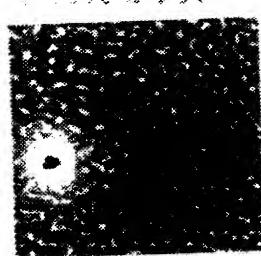


【図3】

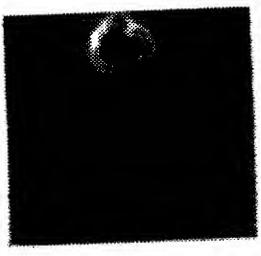
550°CSPC



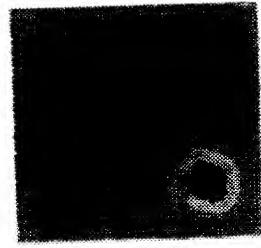
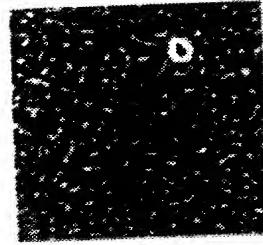
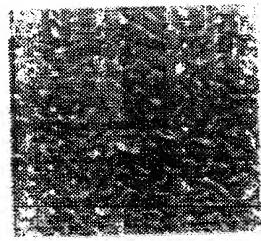
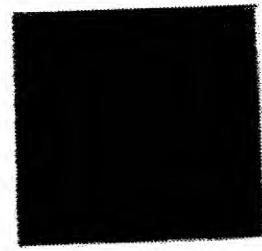
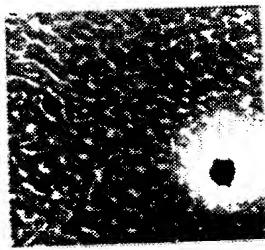
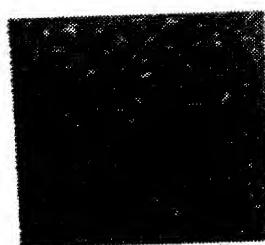
600°CSPC



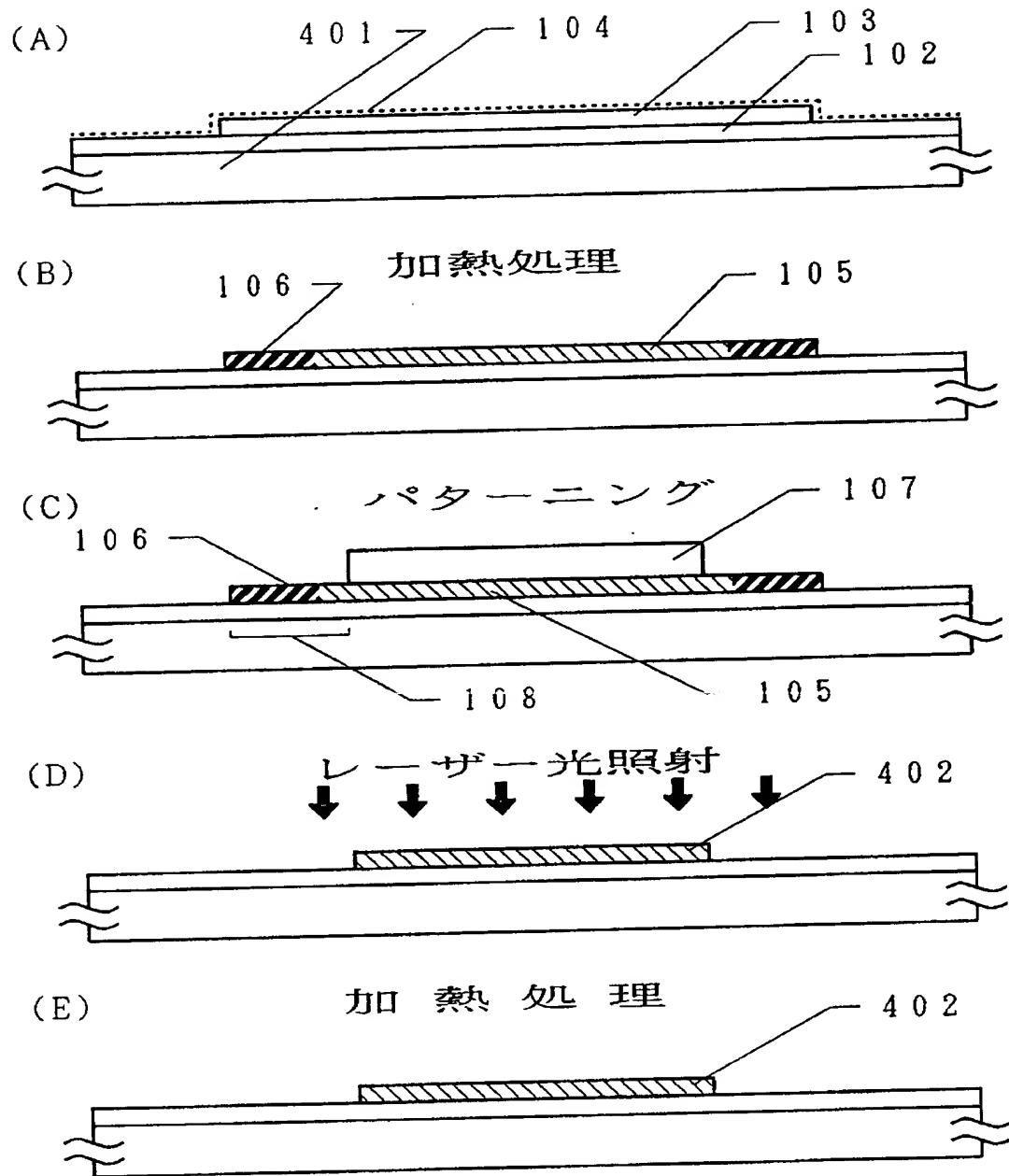
640°CSPC



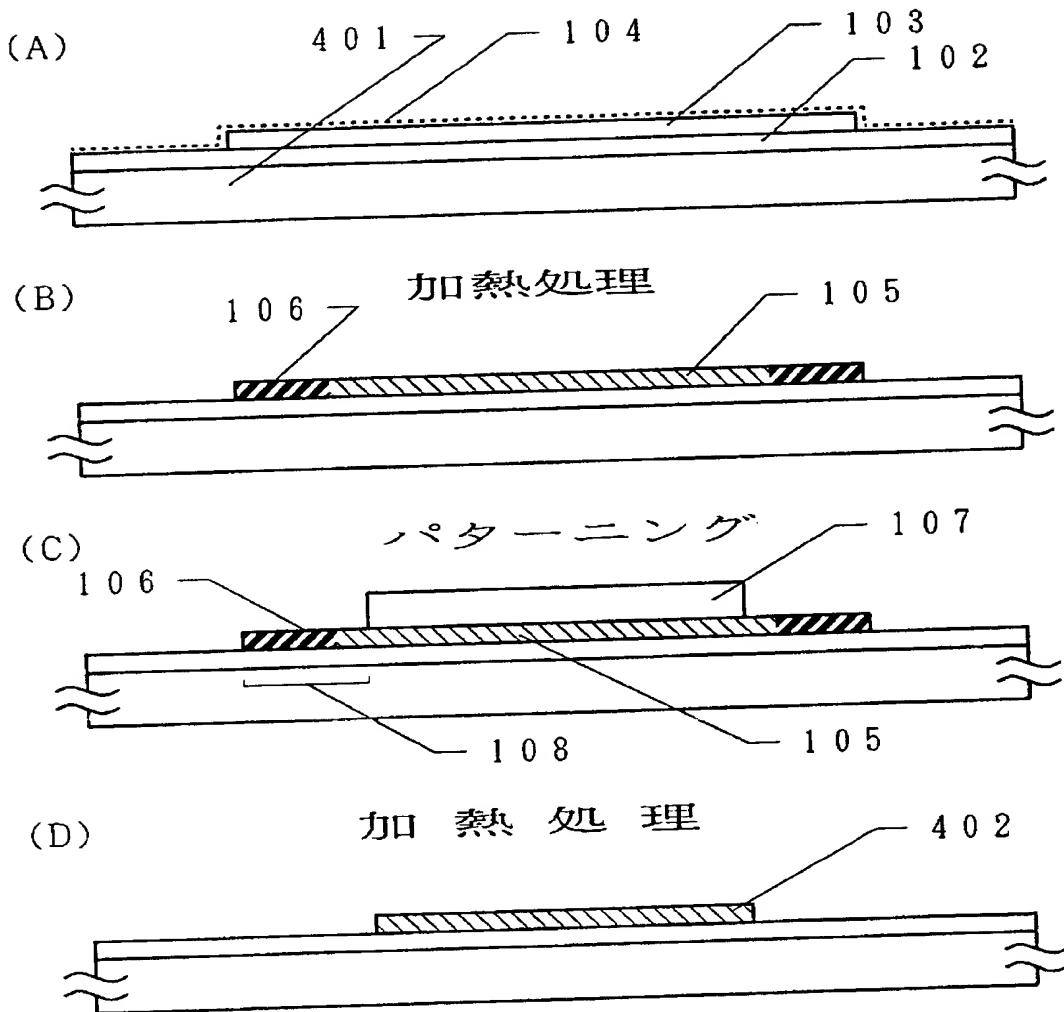
参考用写真



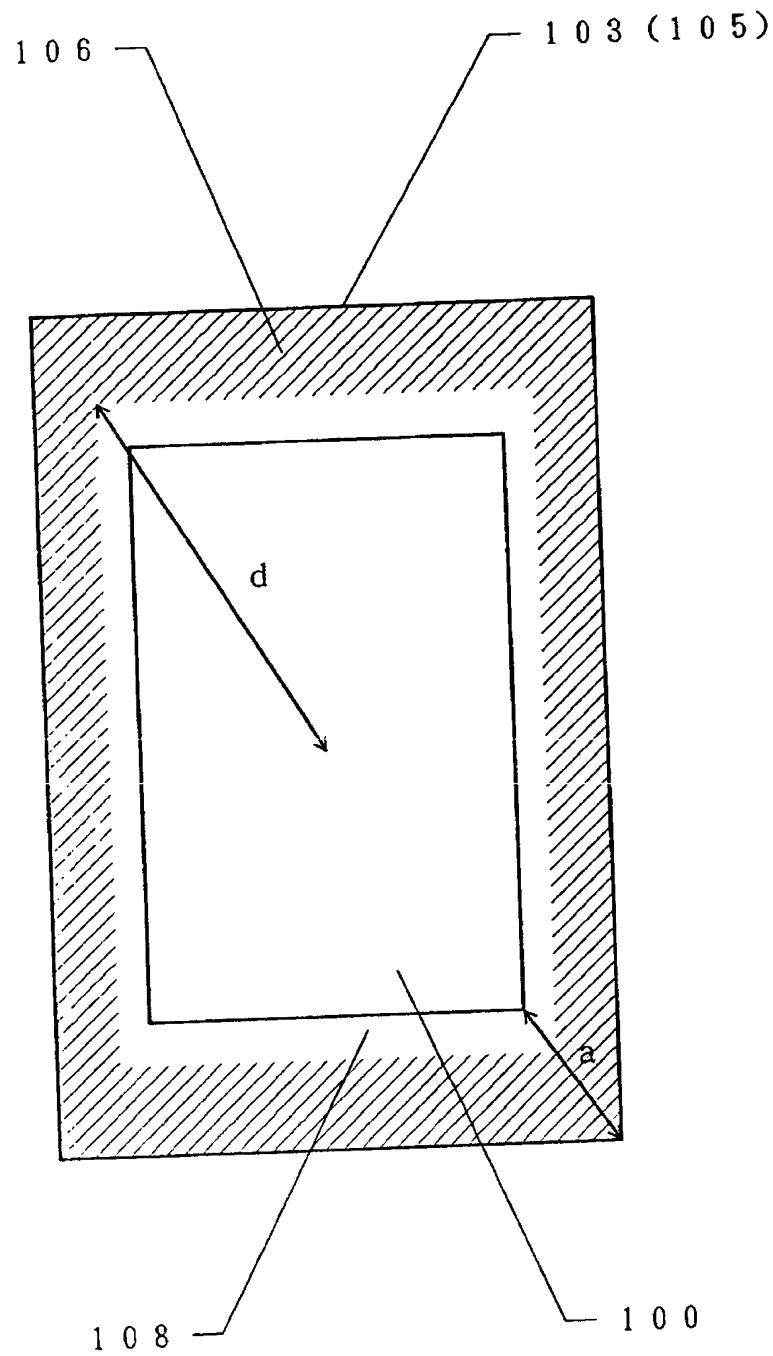
【図4】



【図5】



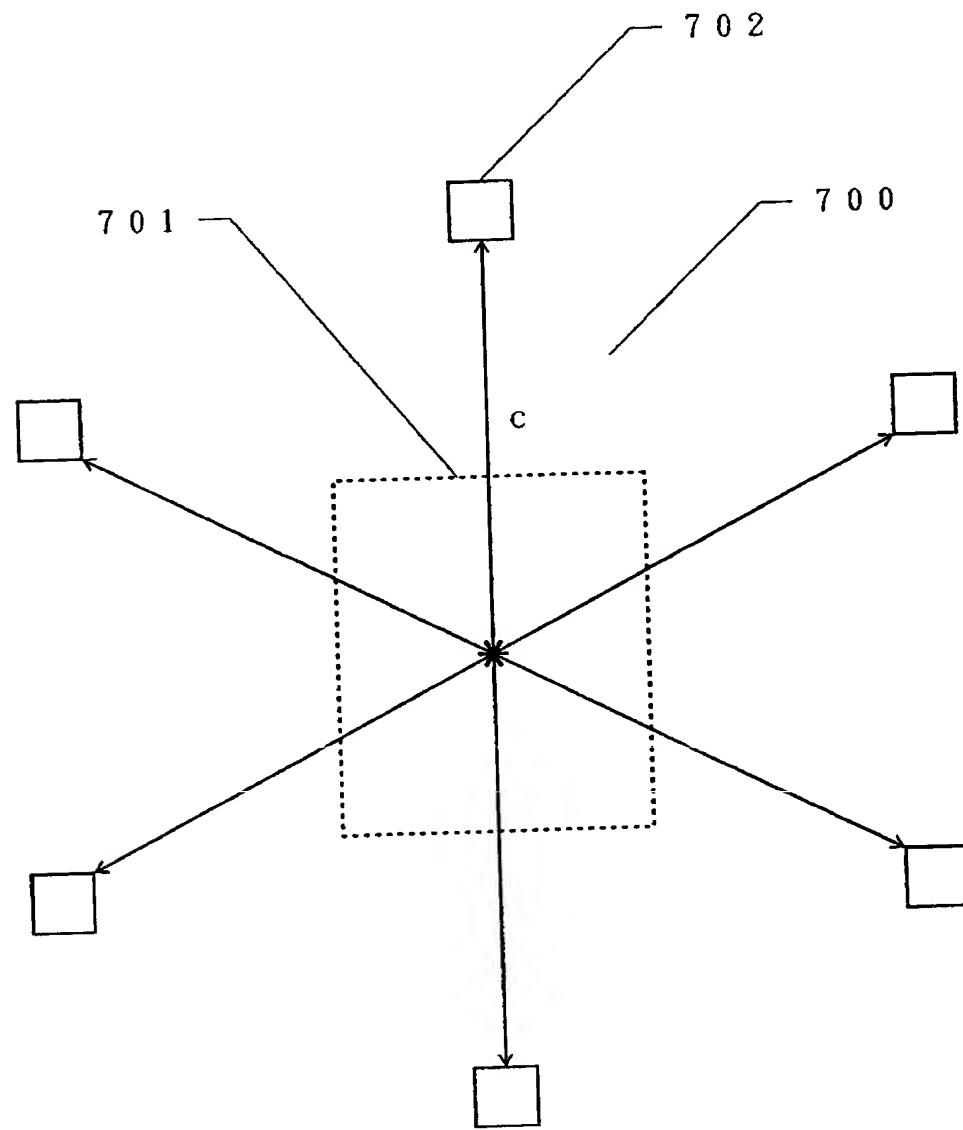
【図6】



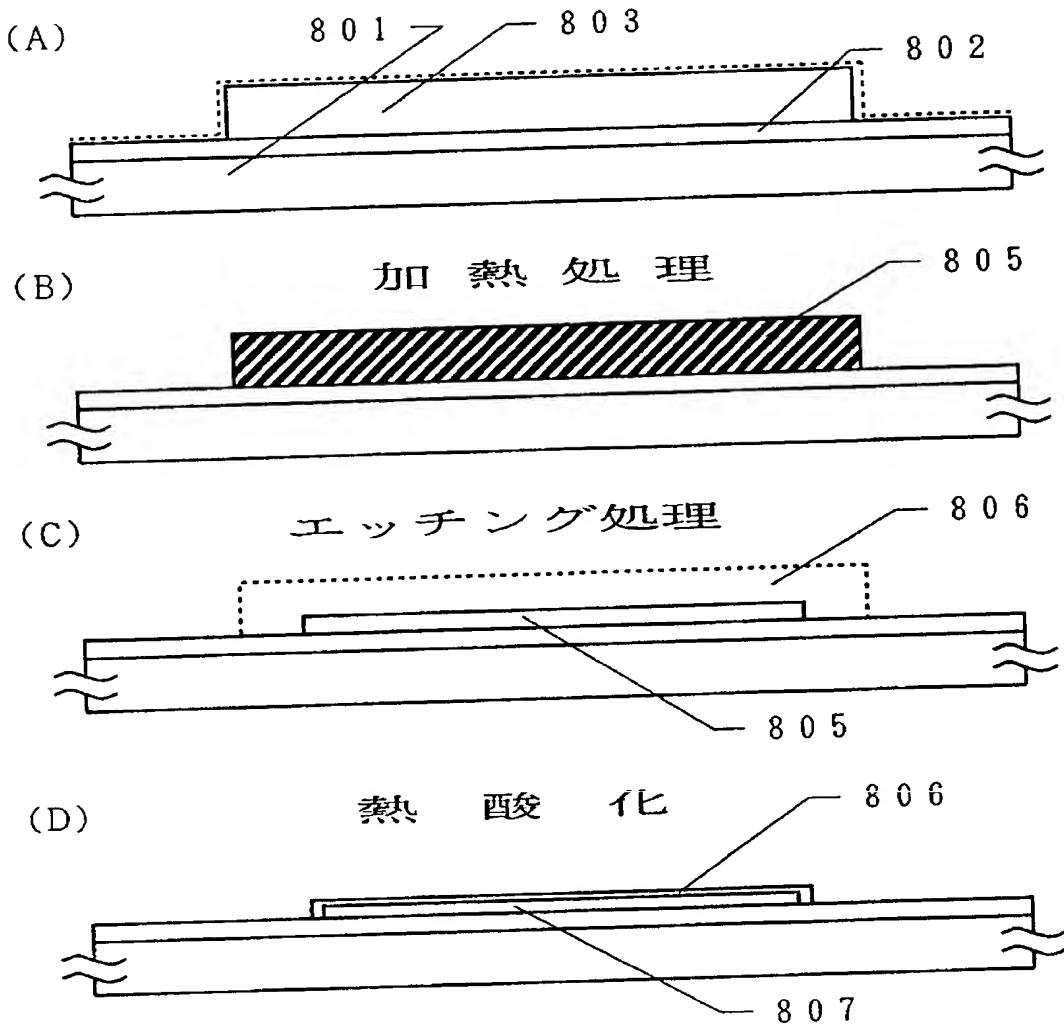
$$d = D / 30 \sim D$$

$$D = D_0 \cdot t \exp(-\Delta E/kT)$$

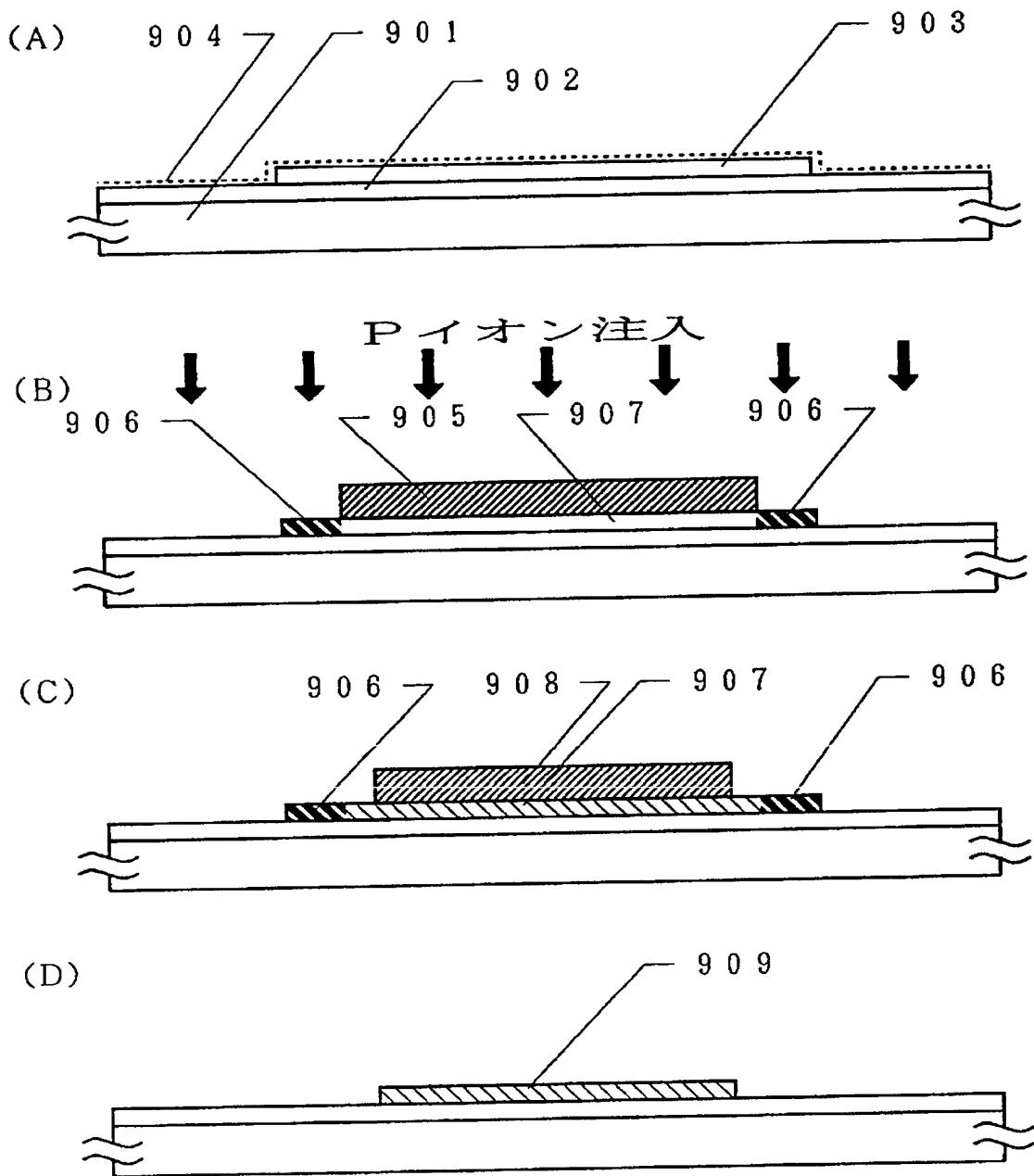
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 硅素の結晶化を助長する金属元素を利用して結晶性硅素膜を得る方法において、金属元素の影響を抑制する。

【構成】 所定のパターニングがされた非晶質硅素膜103の表面にニッケル元素104を接して保持させる。次に加熱処理を加えるころにより、結晶性硅素膜105を得る。この時、パターンの縁の領域106にニッケル元素が偏析する。そしてさらにマスク107を用いてパターニングを行うことによって、金属元素の集中した領域のない結晶性硅素膜100を得る。そしてこの結晶性硅素膜100を活性層として薄膜トランジスタを作製する。

【選択図】 図1

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 特許願

〈認定情報・付加情報〉

【特許出願人】 申請人
【識別番号】 000153878
【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地
【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成 7年12月22日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 平成 7年特許願第216608号
【発明の名称】 半導体装置の作製方法
【補正をする者】
【事件との関係】 特許出願人
【識別番号】 000153878
【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所
【代表者】 山崎 舜平
【発送番号】 030058
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 図面の簡単な説明
【補正方法】 変更
【補正の内容】 1

【図面の簡単な説明】

【図1】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
 【図2】 結晶性珪素膜中の単位面積中に含まれるニッケル元素の固まりの数を示すグラフ図。

【図3】 結晶性珪素膜を示す写真。
 【図4】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
 【図5】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
 【図6】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。
 【図7】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。
 【図8】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。
 【図9】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【符号の説明】

101 ガラス基板
 102 下地膜（酸化珪素膜）
 103 島状にパターニングされた非晶質珪素膜のパターン
 104 膜状に設けられたニッケル元素
 105 島状の形状を有した結晶性珪素膜のパターン
 106 ニッケル元素が偏析した領域
 107 レジストマスク
 108 エッチング除去される領域
 100 結晶性珪素膜でなる活性層
 110 ゲイト絶縁膜（酸化珪素膜）
 111 ゲイト電極
 112 陽極酸化膜
 113 ソース領域
 114 チャネル形成領域
 115 ドレイン領域
 116 層間絶縁膜（酸化珪素膜）
 117 ソース電極

118 ドレイン電極
401 石英基板
402 結晶性珪素膜でなる活性層
700 非晶質珪素膜
701 活性層となるべき領域
702 非晶質珪素膜に形成された開口
801 石英基板
802 酸化珪素膜
803 非晶質珪素膜
804 膜状に設けられたニッケル元素
805 結晶性珪素膜
806 エッティングされる領域
807 活性層
808 ゲイト絶縁膜
903 非晶質珪素膜
904 膜状に設けられたニッケル元素
905 レジストマスク
909 結晶性珪素膜

【書類名】
【訂正書類】

職権訂正データ
手続補正書

〈認定情報・付加情報〉

【補正をする者】

申請人

【識別番号】

000153878

【住所又は居所】

神奈川県厚木市長谷 398 番地

【氏名又は名称】

株式会社半導体エネルギー研究所

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成 8年 4月18日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】 平成 7年特許願第216608号
【発明の名称】 半導体装置の作製方法
【補正をする者】
【事件との関係】 特許出願人
【識別番号】 000153878
【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所
【代表者】 山崎 舜平
【発送番号】 008389
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 図面の簡単な説明
【補正方法】 変更
【補正の内容】 1

【図面の簡単な説明】

【図1】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図2】 結晶性珪素膜中の単位面積中に含まれるニッケル元素の固まりの数を示すグラフ図。

【図3】 結晶性珪素膜表面の結晶構造を示す顕微鏡写真。

【図4】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図5】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図6】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図7】 結晶性珪素膜のパターニングの状態を示す上面図。

【図8】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【図9】 薄膜トランジスタの作製工程を示す図。

【符号の説明】

- 101 ガラス基板
- 102 下地膜（酸化珪素膜）
- 103 島状にパターニングされた非晶質珪素膜のパターン
- 104 膜状に設けられたニッケル元素
- 105 島状の形状を有した結晶性珪素膜のパターン
- 106 ニッケル元素が偏析した領域
- 107 レジストマスク
- 108 エッチング除去される領域
- 100 結晶性珪素膜でなる活性層
- 110 ゲイト絶縁膜（酸化珪素膜）
- 111 ゲイト電極
- 112 陽極酸化膜
- 113 ソース領域
- 114 チャネル形成領域
- 115 ドレイン領域
- 116 層間絶縁膜（酸化珪素膜）
- 117 ソース電極

118 ドレイン電極
401 石英基板
402 結晶性珪素膜でなる活性層
700 非晶質珪素膜
701 活性層となるべき領域
702 非晶質珪素膜に形成された開口
801 石英基板
802 酸化珪素膜
803 非晶質珪素膜
804 膜状に設けられたニッケル元素
805 結晶性珪素膜
806 エッチングされる領域
807 活性層
808 ゲイト絶縁膜
903 非晶質珪素膜
904 膜状に設けられたニッケル元素
905 レジストマスク
909 結晶性珪素膜

【書類名】 職権訂正データ
【訂正書類】 手続補正書

〈認定情報・付加情報〉

【補正をする者】 申請人
【識別番号】 000153878
【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷398番地
【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

出願人履歴情報

識別番号 [000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日

[変更理由] 新規登録

住所 神奈川県厚木市長谷398番地

氏名 株式会社半導体エネルギー研究所